

半導体関係

No.	項 目	単 位	手数料	担当部名
1020	高速反射電子回折測定	1 試料につき	15,460	電子技術部
1030	薄膜屈折率測定	1 試料につき	22,260	〃
1040	定エネルギー分光測定	1 条件につき	33,490	〃
1050	膜厚測定	1 試料 1 測定点につき	6,580	〃
1051	三次元微細形状測定	標準 1 測定当たり	11,040	〃
1060	フォトルミネッセンス測定	1 試料 1 条件につき	40,780	〃
1070	高分解能 (1nm以下) フォトルミネッセンス測定	1 試料 1 条件につき	81,340	〃
1080	低温光特性評価	1 試料 1 条件につき	32,340	〃
1090	位相差測定	1 試料 1 条件につき	10,590	〃
1110	イオンビーム加工試験	1 時間当たり	45,590	〃
1120	酸化拡散試験	1 時間当たり	23,190	〃
1130	光干渉式膜厚測定	1 試料 1 測定点につき	2,880	〃
1140	光干渉式膜厚測定 1 増	1 試料につき 1 測定点増すごとに	1,430	〃
1150	超深度形状測定顕微鏡による観察及び形状測定	1 測定 1 解析につき	7,620	〃
1151	超深度形状測定顕微鏡による観察及び形状測定 1 増	1 解析増すごとに	2,000	〃
1152	ホール効果測定	1 試料 1 条件につき	19,480	〃
1153	超音波ウェッジボンダ試験	1 時間当たり	8,030	〃
1154	超音波ボールボンダ試験	1 時間当たり	9,480	〃
0763	ワイヤーボンディング強度試験	1 測定条件につき (10測定点まで)	19,600	〃
0764	ワイヤーボンディング強度試験 5 増	5 測定点増すごとに	8,980	〃
0765	ダイシエア試験	1 測定条件につき (10測定点まで)	21,420	〃
0766	ダイシエア試験 5 増	5 測定点増すごとに	9,890	〃
1155	ダイシング加工 (半導体基板精密加工)	1 時間当たり	15,750	〃
1156	真空蒸着	標準 1 試料当たり	34,680	〃
1157	真空蒸着	1 条件増すごとに	16,890	〃
1158	スパッタ成膜	標準 1 試料当たり	45,340	〃
1160	イオンプレーティング成膜	標準 1 試料当たり	46,490	〃
1170	イオンプレーティング成膜 1 条件増	1 条件増すごとに	18,010	〃
1180	アッシャーによるプラズマ処理	1 条件 1 時間につき	17,010	〃
1190	E C R プラズマエッチング	標準 1 試料当たり	44,700	〃
1191	高精度リソグラフィ	1 枚につき	23,410	〃
1192	高精度リソグラフィ 1 枚増	1 枚増すごとに	8,570	〃